

	<h2 style="color: #E67E22;">FDB86566-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB86566-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 110A D2PAK
	Datenblätter:  FDB86566-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB86566-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 110A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	176W (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB86566-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6655pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 110A (Tc) 176W (Tj) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDB86566-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB86566-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB86566-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB86566-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB86563-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A TO-263</p>	 <p>FDB8832 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB86566_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A D2PAK</p>	 <p>FDB86569-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>
 <p>FDB86366-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p>FDB86563_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A TO-263</p>	 <p>FDB86366_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB86366_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB86563 FAIRCHILD FDB86563 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB86566-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB86566-F085 Datenblatt	FDB86566-F085-Datenblätter	FDB86566-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB86566-F085
FDB86566-F085 Electronic	FDB86566-F085-Komponenten	FDB86566-F085-Verteiler	FDB86566-F085-Bild	FDB86566-F085-Teil
FDB86566-F085 Preis	FDB86566-F085 Hersteller	FDB86566-F085 Bild	FDB86566-F085 Aktie	FDB86566-F085 Inventar
FDB86566-F085 Neu	FDB86566-F085 Original	FDB86566-F085 garantiert	FDB86566-F085 RFQ	FDB86566-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited